



Quelle Alimentation pour quel Plasma: Générateurs Micro-ondes pour la production de plasma

François Silva

LPICM - UMR 7647, Ecole Polytechnique, Route de Saclay, 91128 Palaiseau

Action Nationale de Formation

1 au 3 Avril 2019, GREMI (Orléans)

Plan

- 1. Introduction sur les plasmas micro-ondes
- 2. Systèmes micro-ondes
 - Générateurs
 - Magnétron
 - Alimentation à Transformateur
 - Alimentation à Découpage
 - Solid State
 - Lignes de transmission
 - Coupleurs directionnels
 - Adaptation d'impédance
 - Systèmes de couplage
- 3. Exemple de réacteur à plasma micro-onde
 - Cavités
 - Plasmas distribués
 - Plasmas ECR
- 4. Conclusion

Introduction: Temps - Fréquence



Introduction: Temps - Fréquence

Pour une excitation basse fréquence dans un plasma non-collisionnel, les électrons et les ions sont perdus principalement aux parois. Pour une chambre de quelques centimètres de long, les électrons la traversent en 20 à 100 μ s.

Donc pour :

- f < 10 kHz (quasi statique) : le plasma s'éteint entre les cycles.</p>
- f > 100 kHz (AC) : le plasma est continu.

En ce qui concerne **les ions**, ils se déplacent à leur vitesse thermique (qq 100 m/s). Pour une épaisseur de gaine non-collisionnelle de 0.5 à 2.5 mm, les ions la traversent en 0,5 à 2,5 μ s. Donc pour :

 f < 1 MHz, les ions traversent la gaine en moins d'un cycle RF et suivent instantanément le potentiel de gaine.

 f > 10 MHz, les ions prennent plusieurs cycles RF pour traverser la gaine et « voient » un potentiel moyenné dans le temps.

Particularités des plasmas micro-ondes

Lorsque $\omega > \omega_{pe} > \omega_{pi}$

ni les électrons, ni les ions ne peuvent suivre les variations du champ E (l'onde excitatrice, ne génère pas de variation temporelle significative de charge d'espace; on a un comportement de décharge quasi-continu).

En raison de la plus haute fréquence d'excitation, les électrons traversent une distance plus courte (par rapport à une excitation RF) avant de changer de direction. Ceci implique que peu d'électrons atteignent la surface au cours d'un cycle MW, minimisant les effets de charge.

La surface présente un potentiel quasi nul.

Il n'y a pas de <u>bombardement ionique</u> indésirable de la surface. De fait, il n'y a <u>pas de phénomènes de pulvérisation</u> ou de contamination des surfaces.

Avantages et Inconvénients

Les plasmas micro-ondes ne nécessitent pas d'électrodes (aucune partie métallique n'est en contact avec le plasma).

Les plasmas micro-ondes sont donc « isotropes » par nature et conviennent parfaitement pour les applications en microélectronique (chip, MEMS ...) qui sont très sensibles aux défauts de surface induits par un bombardement ionique (ex: oxyde de grille des transistors).

Ils sont utilisés pour la production d'espèces actives (« remote plasma »), les procédés de nettoyage de surface, de passivation et fonctionnalisation de surface, de délaquage, de gravure, de dépôt de couches minces....

Les sources plasma sont en général compactes et permettent d'obtenir de **fortes densités plasma**.

Cependant, il est difficile d'obtenir des plasmas homogènes, de grandes dimensions, en utilisant une excitation micro-onde.

Eléments constitutifs d'un réacteur plasma

- <u>Eléments essentiels d'une source plasma micro-onde</u>:
 - Générateur micro-onde (sortie coaxiale ou guide d'onde)
 - Circulateur
 - Système d'accord d'impédance
 - Système de couplage (applicateur)
 - Fenêtre diélectrique
 - Enceinte
 - Piston de court-circuit

Eléments constitutifs d'un réacteur plasma



Alimentation



En l'absence de champ magnétique, les électrons émis par le filament chaud $(1300^{\circ}C)$ traversent radialement l'espace annulaire entre la cathode et l'anode.

En présence du champ magnétique les électrons sont déviés et se mettent à tourner autour de la cathode. Ils excitent les cavités à leur fréquence de résonnance.

Le mouvement des paquets d'électrons autour des cavités provoque l'émission d'une énergie électromagnétique à la fréquence de résonnance des cavités.





Pour les magnétrons de haute puissance (915 MHz), le champ magnétique est produit par un électro-aimant.



Magnétron 2.45 GHz, 1.2 kW $(4.5 \text{ kV}, 0.4 \text{ A}, \eta = 60\%)$



Magnétron 915 MHz, 60 kW (18 kV, 3.8 A, $\eta > 80\%$)

Les magnétrons sont conçus pour fonctionner de façon pleinement opérationnelle à haute puissance.

A basse puissance, le magnétron peut présenter des instabilités de fonctionnement (moding ...) entrainant un spectre d'émission élargi.



Spectre d'émission d'un magnétron 915 MHz



Alimentation à transformateur

La haute tension aux bornes du magnétron est produite par un transformateur et un circuit doubleur de tension (circuit de Villard)



 U_{E} U_{A} U_{A

La stabilité de la haute tension influence directement la stabilité en puissance du magnétron (ripple)

Générateur haute tension d'un four à micro-ondes

Alimentation à transformateur

<u>Avantages</u>:

- Coût modéré
- Robuste

Inconvénients:

- Lourds et encombrants
- Mauvais rendement
- Stabilité en puissance discutable
- Impossibilité d'utiliser le magnétron en mode pulsé

<u>Remarques</u>:

Les alimentations à transformateur tendent à disparaitre pour les générateurs à 2.45 GHz au profit d'alimentations à découpage.

On retrouve encore les transformateurs pour les alimentations à forte puissance pour les générateurs à 915 MHz.

Alimentation à découpage

Dans ce type d'alimentation, la régulation est assurée par des composants électroniques de puissance utilisés en commutation (généralement des transistors). Les alimentations à découpage se sont fortement développées pour pallier les inconvénients des alimentations à transformateur, à savoir, poids élevé et faible rendement.

<u>Avantages</u>:

- Excellente stabilité en puissance
- Très bon rendement
- Compacte
- Possibilité de pulser le magnétron*
- Offre d'autres fonctionnalités (mode boost, burst, ARF)

Inconvénients:

• Prix plus élevé

* Le mode pulsé offre certains avantages dans le cas des plasmas de dépôt (augmentation de la vitesse de croissance, réduction de la génération de particules en phase gazeuse ...)

Troubleshooting

Problème	Cause possible
Faible puissance de sortie	 Courant anodique incorrect SWR incorrect Tension Filament incorrecte Champ magnétique incorrect Puissance incorrecte
Arcing	 SWR incorrect Sortie salle Système de couplage inadapté Guide d'onde salle Puissance de sortie trop élevée
Chute d'émission	 Tension filament incorrecte Tube en fin de vie Pression dans le tube trop élevée
Moding	 Tension filament incorrecte SWR incorrect Tube en fin de vie Temps de préchauffage trop court Pression dans le tube trop élevée Puissance d'alimentation incorrecte

Générateur Micro-onde Solid State

Principe d'un générateur état solide avec un étage d'amplification



Le nombre d'étages d'amplification dépend de la puissance du générateur. Pour un générateur Solid State de 200 W, 4 étages sont nécessaires.

<u>Avantages</u>:

- Agilité en Fréquence (jusqu'à 100 MHz)
- Pureté Spectrale

Inconvénients:

- Prix élevé
- Puissance encore limitée
- Mauvais rendement (<50%)

Générateur Micro-onde Solid State

Spectre d'émission d'une source micro-ondes Magnétron et Solid State



Ligne de transmission



Ligne de transmission Coaxiale



Ligne de transmission Coaxiale

Paramètres primaires	Formules Théoriques	Formules Pratiques
Inductance Linéique	$L_1(H/m) = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(b/a)$	$L_1(\mu H/m) = 0.2\ln(b/a)$
Capacité Linéique	$C_1(F/m) = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln(b/a)}$	$C_1(pF/m) = \frac{55,5\varepsilon_r}{\ln(b/a)}$
Résistance Linéique	$R_1(\Omega/m) = \frac{(a+b)}{2\pi a b \delta_s \sigma_c}$	$R_1(m\Omega/m) = 316\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)\sqrt{\frac{f}{\sigma_c}}$
Conductance Linéique	$G_1(S/m) = \omega C \tan \delta$	$G_1(\mu S/m) = 350 \frac{\varepsilon_r f \tan \delta}{\ln(b/a)}$
Impédance caractéristique	$Z_0(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}} \ln(b/a)$	$Z_0(\Omega) = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln(b/a)$
Pertes dans le conducteur	$\alpha_c(m^{-1}) = \frac{1 + (b/a)}{b \ln(b/a)} \sqrt{\frac{\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r f}{4\sigma_c}}$	$\alpha_c(m^{-1}) = 2.6 \times 10^6 \frac{1 + (b/a)}{b \ln(b/a)} \sqrt{\frac{\varepsilon_r f}{\sigma_c}}$
Pertes dans le diélectrique	$\alpha_d(m^{-1}) = \pi f \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r} \tan \delta$	$\alpha_d(m^{-1}) = 10^{-8} f \sqrt{\varepsilon_r} \tan \delta$
Max peak power		$P_{max}(kW) = 44 E_{max} ^2 a^2 \sqrt{\varepsilon_r} \ln(b/a)$
Cutoff modes supérieurs	$\lambda_c = \pi \sqrt{\varepsilon_r} (a+b)$	

Ligne de transmission Guide d'onde rectangulaire

Mode de propagation TE_{10}





 $E_z = 0$

Longueur d'onde guidée : λ_q

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 + \frac{\lambda_0^2}{4} \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)}}$$

$$P_{max}(kW) = 6,63 \times 10^{-7} abn^2 \sqrt{1 - \left(\frac{n\lambda_0}{2b}\right)^2 |E_{max}|^2}$$

Pour le mode TE₁₀
$$\lambda_a = 2a$$

Coupleur directionnel



Coupleur en croix



Permet de déterminer avec précision la puissance incidente et réfléchie

Adaptateur d'impédance



Existe en version manuelle ou automatique

Piston de court-circuit



Système de couplage

Transition Guide d'onde rectangulaire -Guide d'onde Coaxial



Réacteur à plasma Micro-ondes



Réacteur à plasma Micro-ondes



Plasmas en cavité résonnante

- 1) Introduction
- 2) Modes de résonnance
- 3) Cavité mono-mode
- 4) Cavité multi-modes
- 5) Technique de couplage
- 6) Exemples de réacteurs

Introduction

- Premiers travaux sur les cavités résonnantes au début des années 70 (30 W, 50 mTorr à 100 Torr, $n_e > 2.10^{11}$ cm⁻³).
- Ces premiers résultats ont montré l'efficacité des cavités résonnantes monomodes pour la création de plasmas.
- Par la suite, utilisation pour l'étude de la chimie des plasmas, mais également la propulsion ionique, les faisceaux d'ions, la gravure, le dépôt de couches minces et le traitement de surfaces.
- Les évolutions technologiques se sont orientées vers les plasmas à pressions modérées (0.5 à 200 torr) pour le dépôt de couches minces (diamant...), et les sources basses pression ECR à aimant permanent.

Modes de résonnances

<u>Il existe 2 types de mode de résonnance :</u>

- Transverse Electrique (TE):
- Transverse Magnétique (TM):
- E orthogonal à l'axe de la cavité H orthogonal à l'axe de la cavité



Seuls les modes TM_{Omn} permettent d'obtenir des plasmas axisymétriques

La fréquence de résonnance (ω_0) dépend de la géométrie de la cavité (R, h ...) mais également de son contenu diélectrique (ϵ)

Modes de résonnances



Modes de résonnances

• <u>Modes propres de résonance</u>

Pour les modes

TE
$$f_{mnp} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} \left[\left(\frac{u'_{mn}}{2\pi R} \right)^2 + \left(\frac{p}{2L} \right)^2 \right]^{1/2} \quad (p > 0)$$

Pour les modes TM

$$f_{mnp} = \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} \left[\left(\frac{u_{mn}}{2\pi R} \right)^2 + \left(\frac{p}{2L} \right)^2 \right]^{1/2}$$

 u_{mn} et u'_{mn} sont les zéros des Fonctions de Bessel $J_m(x)$ et $J_m'(x)$

Un mode particulier peut être excité en modifiant la longueur (L) de cavité, la fréquence d'excitation étant généralement fixée (915 ou 2450 MHz).

Cavité mono-mode



Cavité multi-modes



Cavité multi-modes

Lorsque le diamètre de la cavité augmente, le nombre de modes que l'on peut exciter augmente fortement et ils sont très rapprochés en fréquence. La cavité devient alors multi-modes (il est plus difficile de contrôler la structure de champ). Par ailleurs, le spectre d'émission du magnétron présente une certaine largeur spectrale (typiquement 50 MHz). Il sera par conséquent difficile de contrôler l'excitation d'un mode particulier si celui-ci est séparé en fréquence de moins 50 MHz de ses voisins.



L'excitation d'un mode unique est plus facile pour les petites cavités (i.e. dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur de quelques $\lambda/2$).

Techniques de couplage

Le système de couplage permet d'exciter le mode de résonnance de la cavité et de transférer l'énergie micro-onde du générateur à la charge plasma.

Une des composantes du champ d'excitation (E ou H), doit être commune au champ du mode que l'on souhaite exciter.









Techniques de couplage



Techniques de couplage



Méthodes pour coupler une cavité TM_{OnO}

Réacteur plasma type Bell Jar (LSPM)





Réacteur Bell Jar



Réacteur final



Structure de couplage + Fenêtre diélectrique

Exemple de réacteur industriel



F. Silva, A. Michau, X. Bonnin, A. Gicquel, N. Boutroy, N. Chomel and L. Desoutter 2007 Diam. & Relat. Mat. 16 p. 1278

Exemple de réacteur industriel

Procédé de dépôt ACTIS™



TM₀₂₀

Source plasma Coaxiale





Renforcement du champ électrique à l'interruption de la ligne coaxiale

Configuration plasma Matriciel



L. Latrasse, A. Lacoste, J. Sirou and J. Pelletier 2007 *Plasma Sources Science and Technology* **16 p. 7**

Plasma Ar, P = 60 pa, 100 W



Position of microwave applicators



de 20 mm du plan de source

Plasma H_2 , P = 50 pa, 100 W



Configuration plasma Matriciel



Plasma H_2 , P = 50 pa, 100 W



Plasma quasi-homogène à partir de 20 mm du plan de source

Configuration plasma Matriciel (4×4)



Plasma H_2 , P = 50 pa, 100 W/ source



Dépôt de films de diamant nanocristallin sur 150 mm de diamètre (plasma $H_2/CH_4/CO_2$)



Source SAIREM Hi-Wave pour production de plasma à pression intermédiaire (qq 0.1 mbar)

Automatic impedance tuning using variable frequency (SAIREM patent WO 2012146870)

Configuration matricielle



Example of integration of Hi-Wave plasma sources in matrix configuration for the production of a **high density sheet of plasma**



module rack

Plasmas ECR

A basse pression, la puissance est perdue par les pertes aux parois et la création d'électrons chauds, plutôt que de l'ionisation.

L'utilisation d'un champ magnétique permet de pallier cette limitation (la pression doit être suffisamment faible pour que le libre parcours moyen des ions soit de l'ordre de grandeur de la dimension de la chambre).



Un électron mobile interagissant avec un champ magnétique subit une <u>force de</u> <u>Lorentz</u> perpendiculaire à son mouvement

La force étant perpendiculaire à sa vitesse, l'électron décrit un cercle autour de la ligne de champ magnétique (la variation de la vitesse de l'électron change le rayon de son orbite mais pas sa période).

B (Gauss)	Ω (MHz)
100	280
875	2450

L'électron tourne à la **fréquence de précession de Larmor** Ω .

Un champ électromagnétique à la fréquence de Larmor sera en phase avec les électrons et transférera son énergie à chaque cycle. C'est le principe des réacteurs à plasma RCE (Résonnance Cyclotronique Electronique).

Plasma ECR en cavité résonnante



F. C. Sze, D. K. Reinhard, B. Musson, J. Asmussen and M. Dahimene 1990 Journal of Vacuum Science & Technology B **8 p. 1759**

Configuration en couronne



ECR coaxial plasma sources in crown configuration $SST \rightarrow Gas$ $SST \rightarrow Gas$ SS

Source SAIREM Aura-Wave pour production de plasma ECR

Example of integration of Aura-Wave plasma sources in crown configuration for the production of a **high density volume of plasma**

Performances des réacteurs Micro-ondes

Les performances d'un réacteur plasma peuvent être évaluées suivant plusieurs critères:

- Efficacité du couplage micro-onde
- Coût énergétique de production des ions (eV/ion)
- Ne,Te
- Densité de puissance micro-onde
- Dimension de la zone de traitement
- Vitesse de croissance, uniformité de dépôt
- Tenue en puissance du réacteur (durée de vie du quartz ...)

Conclusion

- Plasmas Denses
- Sans électrodes
- Potentiel des surfaces quasi-nul
- Sources Compactes
- Potentiellement transposables sur de grandes surfaces
- L'utilisation d'un chauffage ECR permet d'améliorer l'homogénéité et la densité des plasmas micro-ondes
- Difficile d'obtenir des plasmas homogènes de grandes dimensions à pression modérée